

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分
 【発行日】平成 23 年 3 月 31 日 (2011.3.31)

【公開番号】特開 2010-28146 (P2010-28146A)
 【公開日】平成 22 年 2 月 4 日 (2010.2.4)
 【年通号数】公開・登録公報 2010-005
 【出願番号】特願 2009-252854 (P2009-252854)
 【国際特許分類】

H 0 1 L 23/12 (2006.01)

H 0 1 L 33/48 (2010.01)

H 0 1 S 5/022 (2006.01)

H 0 1 L 23/13 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 23/12 Q

H 0 1 L 33/00 4 0 0

H 0 1 S 5/022

H 0 1 L 23/12 C

H 0 1 L 23/12 N

【手続補正書】

【提出日】平成 23 年 2 月 9 日 (2011.2.9)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

表面に金属層を備えたセラミック基板であって、
 前記金属層は、
 最外層の側に位置し銀からなる銀層と、前記セラミック基板の側に位置しニッケルからなるニッケル層と、該ニッケル層と前記銀層との間に位置する中間層とで構成され、
 前記中間層は、
 ニッケルより高い標準電極電位を有する金属であって、銀とは異なる金属からなる 0.03 ~ 0.2 μm の厚みのストライクメッキ手法で形成された層とされている
 セラミック基板。

【請求項 2】

発光素子を収納するためのセラミック基板であって、
基板本体に形成され、前記発光素子の収納用のキャビティと、
該キャビティの壁面に金属層とを備え、
該金属層は、
最外層の側に位置し銀からなる銀層と、前記セラミック基板の側に位置しニッケルからなるニッケル層と、該ニッケル層と前記銀層との間に位置する中間層とで構成され、
前記中間層は、
ニッケルより高い標準電極電位を有する金属であって、銀とは異なる金属からなる 0.03 ~ 0.2 μm の厚みのストライクメッキ手法で形成された層とされている
セラミック基板。

【請求項 3】

請求項 1 または請求項 2 に記載のセラミック基板であって、

前記金属層は、タングステンまたはモリブデンで構成されるメタライズ層を備え、該メ
タライズ層上に、前記ニッケル層と前記中間層と前記銀層とが順に配置される
セラミック基板。

【請求項 4】

請求項 1 ないし請求項 3 いずれか記載のセラミック基板であって、
前記金属層における前記ニッケル層と前記銀層との間に介在する前記中間層は、その層
厚みが前記ニッケル層および前記銀層の層厚みよりも薄くされているセラミック基板。